

Козярьський І.П. / I.P. Koziarskyi

Патенти / Patents

1. Спосіб виготовлення гетеропереходу типу діода Шотткі на основі наноструктурованого n-Si : пат. 152291 Україна : МПК H01L 33/00, B82Y 40/00. № у 2022 02258 ; заявл. 28.06.2022 ; опубл. 11.01.2023, Бюл. № 2/2023. Солован М. М., **Козярьський І. П.**, Курищук С. І.

2. Спосіб отримання кристалів напівпровідникової сполуки PbI_2 : пат. 152048 Україна : МПК C30B 13/00. № у 2022 01061 ; заявл. 30.03.2022 ; опубл. 19.10.2022, Бюл. № 42/2022. Майструк Е. В., **Козярьський І. П.**, Козярьський Д. П., Уляницький К. С.

3. Спосіб отримання кристалів напівпровідникової сполуки $PbBr_2$: пат. 148663 Україна : МПК C30B 13/00. № у 2021 02027 ; заявл. 19.04.2021 ; опубл. 01.09.2021, Бюл. № 35/2021. Майструк Е. В., **Козярьський І. П.**, Козярьський Д. П., Уляницький К. С.

4. Магнетрон із ізольованим водяним охолодженням : пат. 146893 Україна : МПК C30B 13/00. № у 2020 05995 ; заявл. 21.09.2020 ; опубл. 31.03.2021, Бюл. № 13/2021. Майструк Е. В., **Козярьський І. П.**, Козярьський Д. П., Мар'янчук П. Д.

5. Фотодіод на основі $p\text{-Cd}_3\text{In}_2\text{Te}_6$: пат. 143316 Україна : МПК H01L 33/00. № у 2020 00028 ; заявл. 02.01.2020 ; опубл. 27.07.2020, Бюл. № 14/2020. Майструк Е. В., Солован М. М., **Козярьський І. П.**, Козярьський Д. П., Мар'янчук П. Д.

6. Спосіб отримання кристалів напівпровідникової сполуки Cu_2ZnSnS_4 : пат. 135831 Україна : МПК C30B 13/00. № у 2019 00050 ; заявл. 02.01.2019 ; опубл. 25.07.2019, Бюл. № 14/2019. Майструк Е. В., **Козярьський І. П.**, Козярьський Д. П., Уляницький К. С.

7. Спосіб отримання напівпровідникового матеріалу з обернено пропорційною лінійною залежністю електропровідності від температури : пат. 110938 Україна : МПК C30B 13/00. № у 2016 04164 ; заявл. 15.04.2016 ; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20/2016. **Козярьський І. П.**, Козярьський Д. П., Мар'янчук П. Д.

8. Спосіб отримання напівпровідникового матеріалу з від'ємним температурним коефіцієнтом електропровідності : пат. 104442 Україна : МПК C30B 13/00. № у 2015 08491 ; заявл. 31.08.2015 ; опубл. 25.01.2016, Бюл. № 2/2016. **Козярьський І. П.**, Козярьський Д. П., Мар'янчук П. Д.

9. Спосіб одержання тонких плівок $\text{Cu}_2\text{ZnSnS}_4$ (CZTS) : пат. 103918 Україна : МПК H01L 33/00, C23C 14/35. № у 2015 05389 ; заявл. 02.06.2015 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1/2016. Солован М. М., Майструк Е. В., Мостовий А. І., Мар'янчук П. Д., Брус В. В., Ковалюк Т. Т., Козярський Д. П., **Козярський І. П.**

10. Спосіб отримання напівпровідникового матеріалу з лінійною залежністю електропровідності від температури : пат. 92083 Україна ; МПК C30B 13/00. № у 2014 02682 ; заявл. 18.03.2014 ; опубл. 25.07.2014, Бюл. № 14/2014. **Козярський І. П.**, Козярський Д. П., Майструк Е. В., Мар'янчук П. Д.

11. Спосіб отримання напівпровідникового матеріалу : пат. 84899 Україна : МПК C30B 13/00. № у 2013 03107 ; заявл. 14.03.2013 ; опубл. 11.11.2013, Бюл. № 21/2013. **Козярський І. П.**, Козярський Д. П., Мар'янчук П. Д.